

ОБЪЕДИНЕННЫЙ
ИНСТИТУТ
ЯДЕРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
ДУБНА



10/ix-74

P14 - 7974

Б-202

М.Баланда, В.В.Нитц

3722/2-74

ФАЗОВАЯ ДИАГРАММА ГЕМАТИТА
В МАГНИТНОМ ПОЛЕ.

I. Низкотемпературная модификация.

1974

ЛАБОРАТОРИЯ НЕЙТРОННОЙ ФИЗИКИ

P14 - 7974

М.Баланда, В.В.Нитц

ФАЗОВАЯ ДИАГРАММА ГЕМАТИТА
В МАГНИТНОМ ПОЛЕ.

I. Низкотемпературная модификация.

Направлено в журнал "Физика твердого тела"

1. ВВЕДЕНИЕ. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Кристаллическая структура гематита ($\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$) относится к ромбоэдрической сингонии с пространственной группой $D_{3d}^6 - R\bar{3}c$. Ниже $T_N = 950\text{ K}$ магнитные моменты железа упорядочены антиферромагнитно. Известно, что при температуре ниже точки Морина $T_M = 260\text{ K}$ моменты направлены по ромбоэдрической оси z_3 , при этом $m_x = m_y = m_z = l_x = l_y = 0, l_z \neq 0$ / как и в работе /2/, обозначим это состояние как состояние I/. Выше T_M вектор антиферромагнетизма с хорошей степенью точности перпендикулярен ромбоэдрической оси z_3 . В этом случае, вообще говоря, возможны два состояния: в состоянии II $m_y = m_z = l_x = 0, l_y \neq 0, l_z \neq 0, m_x \neq 0$, в состоянии III $m_x = l_y = l_z = 0, m_y \neq 0, m_z \neq 0, l_x \neq 0$. /Выбрана прямоугольная система координат с осью x , направленной по оси второго порядка, и осью z_3 совпадающей с ромбоэдрической осью кристалла; $\vec{m} = (\vec{M}_1 + \vec{M}_2 + \vec{M}_3 + \vec{M}_4)(4M_0)^{-1}$ - вектор ферромагнетизма, $\vec{l} = (\vec{M}_1 - \vec{M}_2 - \vec{M}_3 + \vec{M}_4)(4M_0)^{-1}$ - вектор антиферромагнетизма/.

При наложении достаточно большого поля вдоль оси z происходит фазовый переход первого рода из состояния с $\vec{l} = (00 l_z)$ в состояние с $\vec{l} \perp z$ /см., например, /3-7/. Внешнее поле, перпендикулярное оси z , приводит к плавному повороту вектора антиферромагнетизма от оси z , и при достаточной величине поля вектор \vec{l} становится практически перпендикулярным оси z /4, 8, 9/. Экспериментально установлено /см., например, работы /7, 8, 10/, что при температуре, достаточно близкой к T_M , при увеличении поля угол между \vec{l} и осью z , достигнув определенного значения, скачком увеличивается до $-\frac{\pi}{2}$, т.е.

происходит фазовый переход первого рода. Однако известные экспериментальные работы не дают прямого ответа на вопрос о наличии такого скачка в низкотемпературной области, например, при температуре жидкого азота.

В данной работе произведен термодинамический анализ поведения в магнитном поле гематита при $T < T_M$. На основе известных экспериментальных данных, при строгом учете симметрии фазовых состояний, рассмотрен вопрос о возможности фазового перехода второго рода при низкой температуре. Хотя анизотропия в базисной плоскости гематита мала, поведение кристалла оказывается существенно зависящим от направления поля в базисной плоскости. Построены фазовые диаграммы в переменных $(h_y h_z T)$ и $(h_x h_y T)$. Основные результаты этого анализа были уже представлены в коротком докладе на конференции /11/.

Термодинамический потенциал кристалла гематита с учетом магнитоупругой связи при наличии внешнего магнитного поля \vec{h} записывается в виде:

$$\Phi = \Phi_M + \Phi_{МУ} + \Phi_{МУ} \quad /1/$$

Здесь, согласно /2/, магнитная энергия равна

$$\begin{aligned} \Phi = & \frac{A}{2} \ell^2 + \frac{C}{4} \ell^4 + \frac{B}{2} m^2 + \frac{D}{2} (\vec{\ell} \vec{m})^2 + \beta (\ell_x m_y - \\ & - \ell_y m_x) + \frac{f}{2} [(\ell_x + i \ell_y)^3 + (\ell_x - i \ell_y)^3] m_z - \frac{a}{2} \ell_z^2 - \\ & - \frac{g}{4} \ell_z^4 + \frac{b}{2} m_z^2 + \frac{d}{2i} [(\ell_x + i \ell_y)^3 - (\ell_x - i \ell_y)^3] \ell_z + \\ & + \frac{e}{2} [(\ell_x + i \ell_y)^6 + (\ell_x - i \ell_y)^6] - (\vec{m} \vec{h}). \quad /2/ \end{aligned}$$

Энергия магнитоупругого взаимодействия, отвечающая симметрии кристалла, в квадратичном относительно компонент вектора антиферромагнетизма приближении имеет вид ^{/12/}:

$$\begin{aligned} \Phi_{\text{МУ}} = & (\delta_1 l_x^2 + \delta_2 l_y^2 + \delta_5 l_y l_z) u_{xx} + (\delta_2 l_x^2 + \delta_1 l_y^2 - \\ & - \delta_5 l_y l_z) u_{yy} + \delta_3 l_z^2 u_{zz} + [2(\delta_1 - \delta_2) l_x l_y + \\ & + 2\delta_5 l_x l_z] u_{xy} + (2\delta_6 l_x l_y + \delta_4 l_x l_z) u_{xz} + \quad /3/ \\ & + [\delta_6 (l_x^2 - l_y^2) + \delta_4 l_y l_z] u_{yz} . \end{aligned}$$

/ u_{ik} - компоненты тензора деформации/.

Упругая энергия кристалла характеризуется упругими постоянными λ_i ^{/12,13/};

$$\begin{aligned} \Phi_{\text{У}} = & \frac{\lambda_1}{2} (u_{xx}^2 + u_{yy}^2) + \lambda_2 u_{xx} u_{yy} + \frac{\lambda_3}{2} u_{zz}^2 + \\ & + \lambda_4 (u_{xx} + u_{yy}) u_{zz} + (\lambda_1 - \lambda_2) u_{xy} + 2\lambda_5 (u_{xz}^2 + \\ & + u_{yz}^2) + 2\lambda_6 [(u_{xx} - u_{yy}) u_{yz} + 2u_{xy} u_{xz}] . \quad /4/ \end{aligned}$$

Получая из системы уравнений

$$\frac{\partial \Phi}{\partial u_{ij}} = 0, \quad (i, j) = x, y, z \quad /5/$$

выражения для равновесных значений $u_{ij}^{(0)}$ и подставляя их в /2/, /3/, /4/, получаем выражение для потенциала:

$$\begin{aligned}
\Phi = & \frac{A}{2} l^2 + \frac{C}{4} l^4 + \frac{B}{2} m^2 + \frac{D}{2} (\vec{l} \cdot \vec{m})^2 - \frac{(a+a_{MY})}{2} l_z^2 - \\
& - \frac{(g+g_{MY})}{4} l_z^4 + \frac{(d+d_{MY})}{2i} [(\ell_x + i\ell_y)^3 - (\ell_x - i\ell_y)^3] l_z + \\
& + \beta (\ell_x m_y - \ell_y m_x) + \frac{f}{2} [(\ell_x + i\ell_y)^3 + (\ell_x - i\ell_y)^3] m_z + \\
& + \frac{e}{2} [(\ell_x + i\ell_y)^6 + (\ell_x - i\ell_y)^6] - (\vec{m} \cdot \vec{h}) + \Phi_{MY}^0. \quad /6/
\end{aligned}$$

Здесь Φ_{MY}^0 - изотропная часть магнитоупругой энергии. Кроме того, магнитоупругая связь проявляется в виде добавок к константам магнитной анизотропии:

$$\begin{aligned}
a_{MY} = & -2[(\delta_1 + \delta_2)(L - 2K) - 2(\delta_1 - \delta_2)M + \delta_3 R + \\
& + 2\delta_4 V + 4\delta_5 N - 2\delta_6 U], \quad /7/
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
g_{MY} = & 4[(\delta_1 + \delta_2)(L - K) - (\delta_1 - \delta_2)M + \delta_3(R - Q) + \\
& + 2\delta_4 V + 4\delta_5 N - \delta_6 U], \quad /8/
\end{aligned}$$

$$d_{MY} = (\delta_1 - \delta_2)N + \delta_4 U + 2\delta_5 M + 2\delta_6 V. \quad /9/$$

В выражениях /7/ - /9/ коэффициенты K, L, M, N, Q, R - известные функции магнитоупругих констант и упругих постоянных /14/.

При температуре, достаточно удаленной от T_N , константа D , определяющая величину парапроцесса при действии поля вдоль вектора \vec{l} , существенно больше обменных констант A, B и C . Поэтому во всех обменных

инвариантах можно положить $\ell^2 = \ell_0^2 - m^2$, где $\ell_0^2(T)$ - квадрат вектора антиферромагнетизма ниже точки Мори-на при отсутствии поля. Для простоты примем $\ell_0^2 = 1$. Во всех инвариантах необменного происхождения ввиду их относительной малости можно не учитывать изменения абсолютной величины вектора антиферромагнетизма, т.е. вместо $|\ell^2|$ использовать $|\ell_0^2|$. Минимизируя при этих условиях потенциал /6/ по m_x, m_y, m_z , получаем энергию в виде зависимости от направления вектора ℓ / θ - угол между ℓ и осью z , ϕ - угол между проекцией ℓ на базисную плоскость и осью x /:

$$\Phi(\theta, \phi) = -\frac{a_1}{2} \cos^2 \theta - \frac{g_1}{4} \cos^4 \theta + d_1 \sin^3 \theta \times \\ \times \cos \theta \sin 3\phi + e \sin^6 \theta \cos 6\phi - \frac{H_{||}^2}{2(B_1 + D)} - \frac{H_{\perp}^2}{2B_1} \quad /10/$$

$$(a_1 = a + a_{МУ}, g_1 = g + g_{МУ}, d_1 = d + d_{МУ}),$$

где $H_{||}$ - проекция эффективного магнитного поля

$$\vec{H}(H_x = h_x + \beta \sin \theta \sin \phi, H_y = h_y - \beta \sin \theta \cos \phi,$$

$$H_z = h_z + f \sin^3 \theta \cos 3\phi)$$

на ось антиферромагнетизма:

$$H_{||} = (h_x \cos \phi + h_y \sin \phi) \sin \theta + (h_z + f \sin^3 \theta \cos 3\phi) \cos \theta; /11/$$

H_{\perp} - компонента эффективного поля \vec{H} , перпендикулярная оси антиферромагнетизма, т.е.

$$H_{\perp}^2 = H_x^2 + H_y^2 + H_z^2 - H_{||}^2. \quad /12/$$

В выражении /10/ $B_1 = B - A - C$.

Характер индуцированных внешним магнитным полем фазовых переходов существенно зависит от направления

проекция поля на базисную плоскость относительно осей второго порядка ^{/15/}. Если поле перпендикулярно оси второго порядка, при повороте вектора $\vec{\ell}$ к базисной плоскости осуществляется фазовый переход первого или второго рода. В магнитном поле, параллельном оси второго порядка, если и имеет место фазовый переход, то только первого рода, т.к. при любой величине поля кристалл находится в неизменном состоянии симметрии /состояние II /.

Наиболее существенным членом в магнитной энергии, приводящим к различию поведения в поле h_x и h_y , является $d_1 \sin^3 \theta \cos \theta \sin 3\phi$. Из-за относительной малости константы d_1 это различие не проявилось в экспериментах по изучению поведения гематита в сильном магнитном поле /например, ^{/16/} /. Следовательно, можно использовать данные по определению величины поля, при котором осуществляется поворот вектора $\vec{\ell}$ к плоскости (111), не принимая во внимание обычной для многих работ неопределенности направления поля в базисной плоскости.

2. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ В ПЛОСКОСТИ СИММЕТРИИ

При увеличении магнитного поля, перпендикулярного оси второго порядка ($\vec{H} = (0h_y h_z)$), осуществляется фазовый переход IV \rightarrow III ^{/15/}. Здесь IV - состояние симметрии, в котором кристалл находится уже при сколь угодно малой величине поля /единственный элемент симметрии точечной группы - центр инверсии; при этом все компоненты векторов \vec{m} и $\vec{\ell}$ не равны нулю/. Симметрией состояний допускается при этом фазовый переход второго рода.

Следует отметить, что при повороте моментов под действием возрастающего поля вектор $\vec{\ell}$ не перпендикулярен оси y , пока не произойдет переход в состояние III. В частном случае, когда $\vec{h} = (0h_y 0)$, при малой величине поля минимизацией выражения ^{/10/} по углу ϕ получаем соотношения:

$$\sin \phi = - \frac{3\beta d_1 \cos \theta}{B_1(a_1 - \frac{\beta^2}{B_1})} h_y, \cos \phi < 0 - \text{при } h_y > 0$$

/13/

$$\sin \phi = \frac{3\beta d_1 \cos \theta}{B_1(a_1 - \frac{\beta^2}{B_1})} h_y, \cos \phi > 0 - \text{при } h_y < 0.$$

В более общем случае ($h_y \neq 0, h_z \neq 0$) в состоянии IV $\sin \phi \neq 0$, если даже пренебречь инвариантами $d_1 \sin^3 \theta \cdot \cos \theta \sin 3\phi$ и $e \sin^6 \theta \cos 6\phi$, а также величиной $f \sin^3 \theta \cos 3\phi$. Учтем это обстоятельство при рассмотрении перехода IV \rightarrow III вдали от T_M , т.е. когда константа β /равная $2,1 \cdot 10^4$ Э /17//, существенно меньше величины поля h_y , необходимого для фазового перехода /10 \div $15 \cdot 10^4$ Э/. В результате минимизация энергии по ϕ вблизи точки фазового перехода получаем:

$$\sin \phi = - \frac{h_z}{h_y} (1 - \frac{\beta}{h_y}) \cos \theta. \quad /14/$$

После подстановки этого соотношения в /10/ энергия представляется в виде разложения по степеням $\cos^2 \theta$:

$$\begin{aligned} \Phi = \Phi_0 - \frac{1}{2} [a_1 - \frac{\beta^2}{B_1} - \frac{\beta h_y}{B_1} - \frac{\beta h_z^2}{B_1 h_y} (1 - \frac{\beta}{h_y})] \cos^2 \theta - \\ - \frac{1}{8} [2g_1 - \frac{\beta h_y}{B_1} + \frac{4h_z^2}{B_1} (\frac{\beta}{2h_y} + \frac{b}{B_1})] \cos^4 \theta + \dots \end{aligned} \quad /15/$$

Отсюда, в соответствии с теорией фазовых переходов /18/, получаем условия для фазового перехода второго рода:

$$\frac{\beta h_{y0}}{B_1} + \frac{\beta h_{z0}^2}{B_1 h_{y0}} (1 - \frac{\beta}{h_{y0}}) = a_1 - \frac{\beta^2}{B_1}$$

$$\frac{\beta h_{y_0}}{B_1} - \frac{4h_{z_0}^2}{B_1} \left(\frac{\beta}{2h_{y_0}} + \frac{b}{B_1} \right) > 2g_1 . \quad /16/$$

Здесь h_{y_0} и h_{z_0} - значения компонент магнитного поля, при котором осуществляется переход.

На фазовой диаграмме /рис. 1/ изображена поверхность, разделяющая состояния IV и III. Участок этой поверхности при низкой температуре, ограниченный линией O_1B , удовлетворяет условиям /16/, т.е. является поверхностью фазового перехода второго рода. Приняв в соотношениях /16/ знаки равенства, получаем выражения для компонент поля на критической линии фазового перехода второго рода или, как мы будем далее ее называть, на трикритической линии O_1B :

$$h_y = \frac{2B_1}{3\beta} \left(a_1 - \frac{\beta^2}{B_1} + g_1 \right)$$

$$h_z^2 = \frac{2B_1^2}{9\beta^2} \left(a_1 - \frac{\beta^2}{B_1} + g_1 \right) \left(a_1 - \frac{\beta^2}{B_1} - 2g_1 \right) . \quad /17/$$

При написании этих выражений для простоты пренебрегались величиной β/h_y по сравнению с единицей и анизотропией ферромагнитного момента ($b=0$).

Поверхность, показанная на рис. 1 вне трикритической линии O_1B , является поверхностью равновесия фазовых состояний III и IV и определяется из условия равенства энергий этих состояний. В этой области фазовой диаграммы при увеличении магнитного поля угол θ , достигнув определенного значения, скачком увеличивается до 90° , т.е. осуществляется фазовый переход первого рода.

Вопрос о возможности фазового перехода второго рода при низкой температуре в поле, перпендикулярном оси z , уже обсуждался в /19,20/. Прямых поисков трикритической точки не производилось, и имеющиеся экспери-

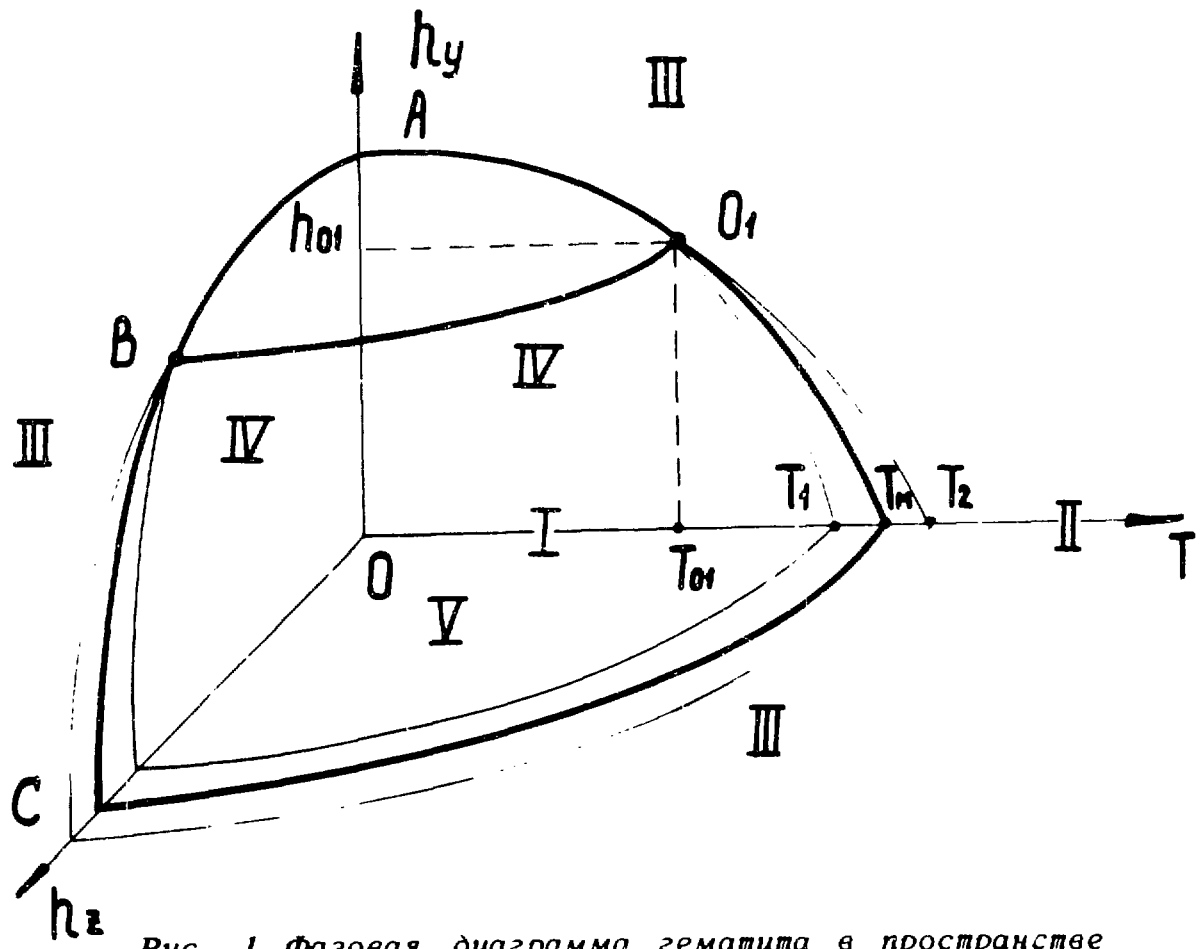


Рис. 1. Фазовая диаграмма гематита в пространстве (h_y, h_z, T) ниже точки Морина.

=

ментальные данные не позволяют решить вопрос о существовании такой точки однозначно. Однако температурные зависимости поля, при котором вектор \vec{r} становится перпендикулярным ромбоэдрической оси, в случаях $\vec{h} \perp z$ и $\vec{h} \parallel z$, определенные довольно точно /например, /7,16//, позволяют нам косвенно рассмотреть вопрос о трикритической точке O_1 в плоскости (h_y, T) . Известные исследования /19,20/ представляются нам недостаточно удовлетворительными.

Используя выражение для поля фазового перехода второго рода

$$h_{y0} (h_z = 0) = \frac{B_1}{\beta} \left(a_1 - \frac{\beta^2}{B_1} \right), \quad /18/$$

получающееся из /16/, соотношение для поля h_{z0} перехода первого рода, следующее из условия $\Phi(\theta=0) = \Phi(\theta=\frac{\pi}{2})$:

$$h_{z0}^2 (h_y = 0) = \frac{(B_1 + b)(B_1 + b + D)}{D} \left(a_1 - \frac{\beta^2}{B_1} + \frac{g_1}{2} \right), \quad /19/$$

и условии для трикритической точки O_1

$$a_1 - \frac{\beta^2}{B_1} - 2g_1 = 0, \quad // /20/$$

получаем соотношение, которое должно выполняться при температуре T_{01} /см. рис. 1/:

$$\chi_{||}(\theta = \frac{\pi}{2}) - \chi_{||}(\theta = 0) = \frac{5}{4} m_0 \frac{h_{y0}(h_z = 0)}{h_{z0}^2(h_y = 0)}. \quad /21/$$

Здесь $\chi_{||}(\theta = \frac{\pi}{2}) = \frac{1}{B_1 + b}$, $\chi_{||}(\theta = 0) = \frac{1}{B_1 + b + D}$ - восприимчивости в параллельном относительно оси z направлении при $\theta = \frac{\pi}{2}$ и $\theta = 0$; $m_0 = \beta/B_1$ - спонтанный магнитный момент при $\theta = \frac{\pi}{2}$.

Все величины, входящие в соотношение /21/, определялись экспериментально с той или иной точностью. Наибольшая относительная неопределенность связана с $\chi_{||}(\theta = 0)$. Экспериментальные значения $\chi_{||}(\theta = 0)$, полученные в разных работах /например, /4,17//, сущест-

венно различаются между собой и превышают значения, ожидаемые из теории молекулярного поля /см., например, /21/ /. Если использовать температурную зависимость $\chi_{||}(\theta=0)$, следующую из теории молекулярного поля, и значения

$$\chi_{||}(\theta=\frac{\pi}{2}) = 17,5 \cdot 10^{-6} \frac{\text{эрг}}{\text{Гс} \cdot \text{г} \cdot \text{Э}} \text{ и } m_0 = 0,4 \quad , \quad /22/$$

то условие /21/ выполняется при $T_{01} = 120 \text{ К} / h_{01} = 155 \text{ кЭ} /$. При этом $\chi_{||}(\theta=0) = 10^{-8} \frac{\text{эрг}}{\text{Гс} \cdot \text{г} \cdot \text{Э}}$. Значение $\chi_{||}(\theta=0) = 0,5 \cdot 10^{-6} \frac{\text{эрг}}{\text{Гс} \cdot \text{с} \cdot \text{Э}}$, полученное для гематита при $T=140 \text{ К}$ экспериментально /4/, более благоприятно для существования трикритической точки. Если принять это значение и при более высокой температуре, координаты трикритической точки

$$T_{01} = 165 \text{ К} \quad , \quad h_{01} = 135 \text{ кЭ}.$$

Полученный в работе /19/ вывод о том, что при любой температуре $T < T_M$ в поле, перпендикулярном оси z , происходит фазовый переход первого рода, не точен, так как при этом не принималась во внимание анизотропия ферромагнитного момента /член $\frac{b}{2} m_z^2$ в выражении для энергии/, т.е. фактически в формуле /21/

$$\text{вместо } \chi_{||}(\theta = \frac{\pi}{2}) \text{ использовалось } \chi_{\perp}(\theta = \frac{\pi}{2}) = \frac{1}{B_1} .$$

Различие величин $\chi_{||}(\theta = \frac{\pi}{2})$ и $\chi_{\perp}(\theta = \frac{\pi}{2})$ и, следо-

вательно, существенное значение константы анизотропии b можно считать хорошо установленным. В работе /22/ приводятся значения $\chi_{||}(\theta = \frac{\pi}{2}) = 17,5 \cdot 10^{-6}$ и $\chi_{\perp}(\theta = \frac{\pi}{2}) =$

$$= 19,5 \cdot 10^{-6} \frac{\text{эрг}}{\text{Гс} \cdot \text{с} \cdot \text{Э}} \text{ Различие между этими восприимчи-}$$

востями подтверждается также работой /17/.

3. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ В БАЗИСНОЙ ПЛОСКОСТИ

Рассмотрим подробнее случай $\vec{h} = (h_x, 0, 0)$. Характер изменения угла θ в поле h_x описывается уравнением, получаемым из условия $\frac{\partial \Phi}{\partial \theta} = 0$ /в этом случае $\cos \phi = 0$ /15/ /:

$$\left(a_1 - \frac{\beta^2}{B_1} + g_1 \cos^2 \theta \right) \sin \theta \cos \theta + d_1 \sin^2 \theta (1 - 4 \cos^2 \theta) - \frac{\beta}{B_1} h_x \cos \theta = 0. \quad /22/$$

Как видно, отличие от случая $\vec{h} = (0, h_y, 0)$ обусловлено инвариантом $d_1 \sin^3 \theta \cos \theta \sin 3 \phi$ /величинами f и e пренебрегаем/. Очевидно, что если величина $|d_1|$ достаточно мала, то в температурной области, в которой при $\vec{h} = (0, h_y, 0)$ осуществляется фазовый переход первого рода, при $\vec{h} = (h_x, 0, 0)$ также имеет место скачок и фазовый переход первого рода /но без изменения симметрии состояния/. При низкой же температуре, где в поле $\vec{h} = (0, h_y, 0)$ осуществляется фазовый переход второго рода, при $\vec{h} = (h_x, 0, 0)$ в этом случае имеем непрерывный поворот вектора антиферромагнетизма без фазового перехода. На фазовой диаграмме (h_x, T) в таком случае существует критическая точка O_B /см. рис. 2/, при приближении к которой со стороны высоких температур величина скачка стремится к нулю. Точка O_B аналогична, например, критической точке системы жидкость - пар.

На основе уравнения /22/ нами произведены расчеты /с помощью вычислительной машины/ зависимости температуры критической точки от величины константы d_1 /рис. 3/. При этом принималось, что $\beta = 2,1 \cdot 10^4 \text{ Э}$ /17/, $B_1 = 18,3 \cdot 10^6 \text{ Э}$ /22/, а необходимые в расчетах температурные зависимости констант анизотропии $(a_1 - \beta^2/B_1)$ и g_1 были получены с помощью формул /18/ и /19/ с исполь-

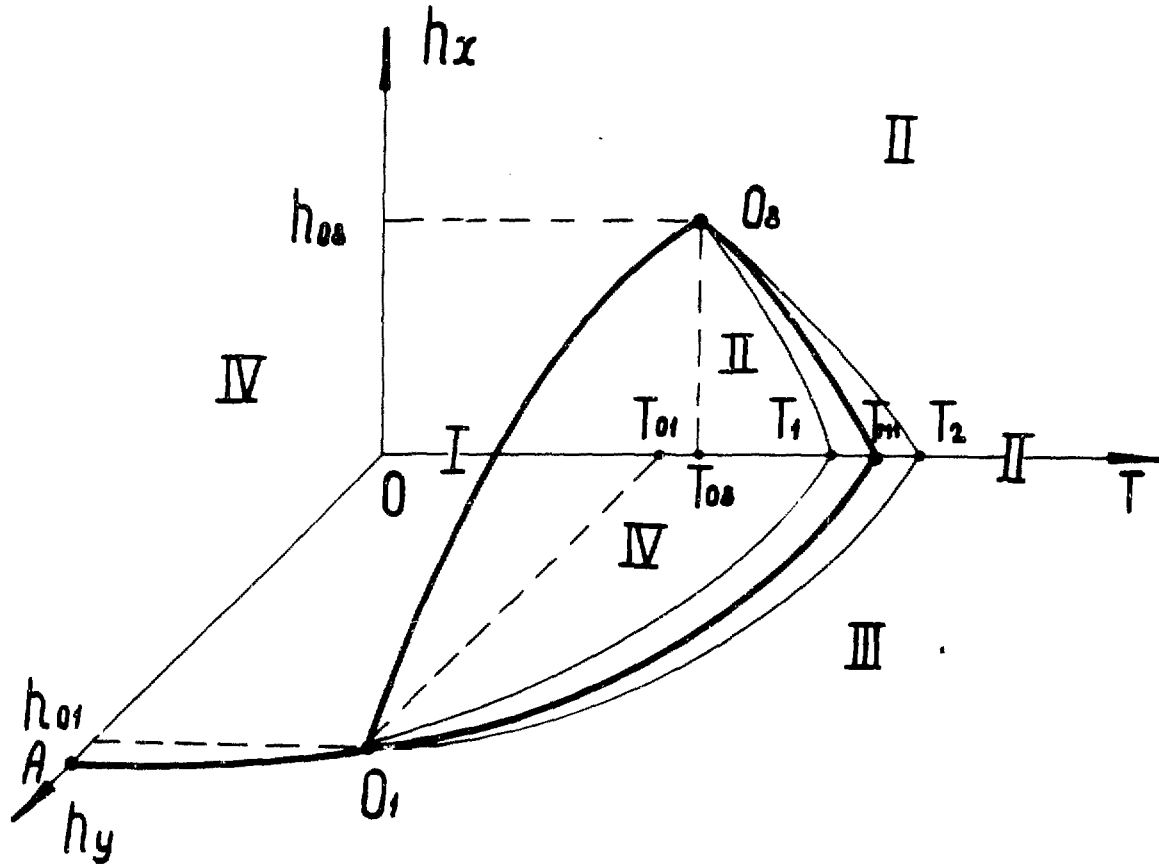


Рис. 2. Фазовая диаграмма гематита в пространстве (h_x, h_y, T) ниже точки Морина.

зованием экспериментальных значений критических полей $h_{y0} (h_z = 0)$ и $h_{z0} (h_y = 0)$ ^{/7,16/} и восприимчивостей $\chi_{||} (\theta = 0)$ и $\chi_{||} (\theta = \frac{\pi}{2})$ ^{/22/}. Видим, что в любом случае $T_{08} > T_{01}$.

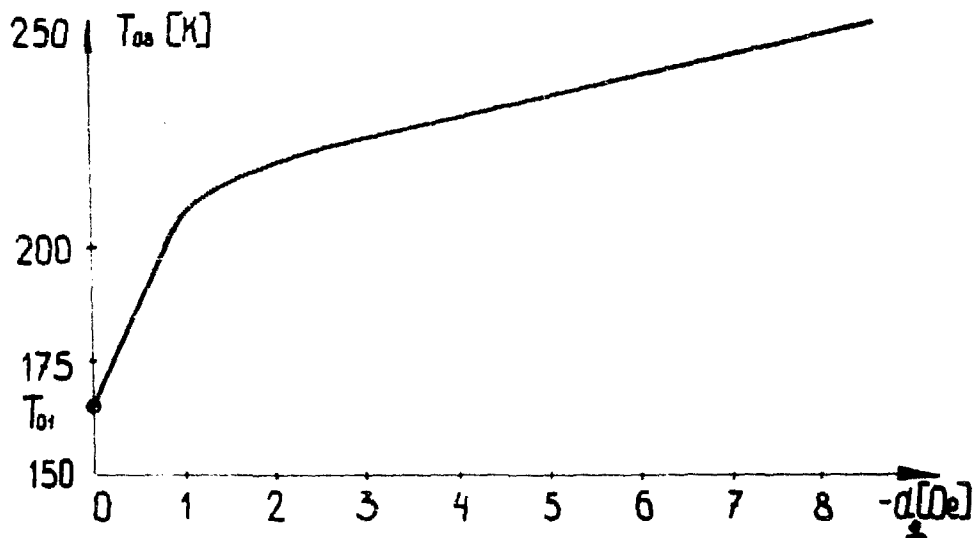


Рис. 3. Зависимость температуры критической точки в плоскости $(h_x T)$ от величины константы анизотропии d_1 .

Значения $|d_1|$ ниже точки Морина могут быть определены из измерений магнитной анизотропии в плоскости /111/ кристалла гематита, произведенных методом вращающего момента^{/23/}. При действии в базисной плоскости магнитного поля \vec{h}_0 , существенно большего, чем эффективное поле анизотропии в плоскости ($|\vec{h}_0| \gg |d_1|$), как это имело место в работе^{/23/}, вектор антиферромагнетизма можно считать перпендикулярным направлению поля, т.е. $\phi = \frac{\pi}{2} + \phi_H$, где ϕ_H - угол между \vec{h}_0 и осью x . В таком случае вращающий момент

$$\mathcal{L} = \frac{d\Phi}{d\phi_H} = 3d_1 \sin^3 \theta \cos \theta \sin 3\phi_H = \mathcal{L}_0 \sin 3\phi_H. \quad /23/$$

Значения входящего в выражение /23/ угла θ можно считать не зависящими от направления поля в базисной плоскости и определить с помощью /22/, пренебрегая членом с множителем d_1 . Используя представленные в работе /23/ зависимости амплитуды вращающего момента ξ_0 от h_0 при различных температурах, получаем показанную на рис. 4 температурную зависимость константы d_1 /из нейтронодифракционных измерений /24/ следует, что $d_1 < 0$ /.

Сопоставляя рис. 3 и рис. 4, получаем следующие координаты критической точки: $T_{08} = 180$ К, $h_{08} = 120$ кЭ.

В более общем случае $\vec{h} = (h_x h_y 0)$ кристалл находится в неизменном состоянии симметрии IV, т.е., как и при $\vec{h} = (h_x 0 0)$, остается возможным лишь фазовый переход первого рода без изменения симметрии /15/. На фазовой диаграмме $(h_x h_y T)$ /рис. 2/ трикритическая точка O_1 соединяется с критической точкой O_8 непрерывной линией $O_1 O_8$ критических точек, которая ограничивает поверхность равновесия двух термодинамических минимумов состояния IV.

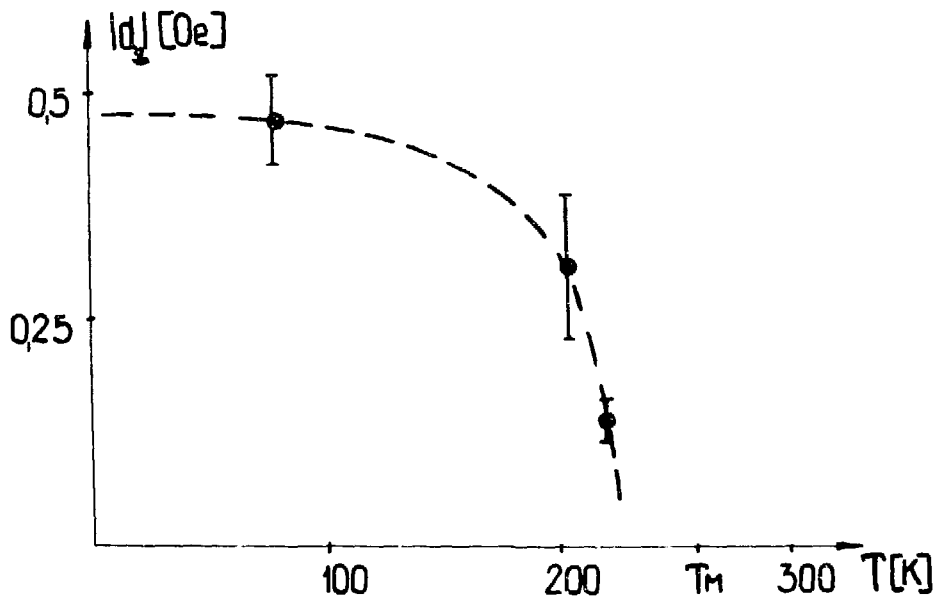


Рис. 4. Температурная зависимость константы анизотропии d_1 , полученная на основании результатов измерений вращающего момента /23/.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. При наличии трикритической точки в плоскости $(h_y T)$ фазовой диаграммы существует трикритическая линия в пространстве $(h_x h_y T)$. Получены уравнения этой линии и уравнения поверхности фазового перехода второго рода, ограничиваемой трикритической линией в низкотемпературной области.

Анализ известных экспериментальных данных показывает, что существование трикритической точки в плоскости $(h_y T)$ при $T < T_M$ возможно в рамках теории молекулярного поля. Экспериментальные данные по продольной восприимчивости подтверждают существование трикритической точки.

2. При действии поля h_x возможен фазовый переход первого рода без изменения симметрии кристалла. В этом случае в плоскости $(h_x T)$ существует критическая точка, а в пространстве $(h_x h_y T)$ - критическая линия, соединяющая трикритическую точку в поле h_y с критической точкой в поле h_x .

Представлены результаты расчета температурной зависимости константы анизотропии d_1 , на основании которой получены координаты критической точки в плоскости $(h_x T)$.

Авторы благодарят И.Коцева, Ю.М.Останевича и Е.А.Ткаченко за полезные обсуждения.

ЛИТЕРАТУРА

1. C.Shull, W.Strauser, E.Wollan. *Phys.Rev.*, 83, 333 (1951).
2. И.Е.Дзялошинский. *ЖЭТФ*, 32, 1547 /1957/.
3. P.J.Besser, A.H.Morrish. *Phys.Lett.*, 13, 289 (1964).
4. Р.А.Восканян, Р.З.Левитин, В.А.Щуров. *ЖЭТФ*, 53, 459 /1967/.
5. N.Blum, A.J.Freeman, J.W.Strauser, L.Grodzins. *J.Appl.Phys.*, 36, 1169 (1965).
6. S.Foner, *Proc.Intern.Conf.Magnetism, Nottingham, England 1964*, p.438.
7. S.Foner, Y.Shapira. *Phys.Lett.*, 29A, 276 (1969).

8. P.J.Flanders, S.Strikman. *Solid State Comm.*, 3, 285 (1965).
9. G.Cinader, S.Strikman. *Solid State Comm.*, 4, 459 (1966).
10. P.J.Flanders. *J.Appl.Phys.*, 40, 1247 (1969).
11. М.Баланда, В.В.Нитц. Международная конференция по магнетизму. Москва, август 1973, т. 2, изд. "Наука", М., 1974.
12. Е.А.Туров, В.Г.Шавров. *ФТТ*, 7, 217 /1965/.
13. Л.Д.Ландау, Е.М.Лифшиц. *Теория упругости*. М., изд. "Наука", 1965.
14. А.С.Пахомов. *ФММ*, 25, 769 /1968/.
15. В.В.Нитц. *ФТТ*, 16, 213, 1974; *ОИЯИ*, Р4-7397, Дубна, 1973.
16. Y.Shapira. *Phys.Rev.*, 184, 589 (1969).
17. L.Neel, R.Pauthenet, C.R.Acad.Sci., Paris, 234, 2172 (1952).
18. Л.Д.Ландау. *ЖЭТФ*, 7, 19 /1937/.
Л.Д.Ландау, Е.М.Лифшиц. *Статистическая физика*, Изд. "Наука", 1964.
19. I.S.Jacobs, R.A.Beyerlein, S.Foner, J.P.Remeika. *Intern.J.Magnetism*, 1, 193 (1971).
20. Р.З.Левитин, В.А.Щуров. *ЖЭТФ*, *Письма*, 7, 142 /1968/.
21. Дж.Смарт. "Эффективное поле в теории ферромагнетизма", изд. "Мир", 1968.
22. Т.Конэко, С.Абе, *J.Phys.Soc.Japan*, 20, 2001 (1965).
23. А.А.Богданов. *ФТТ*, 14, 3362 /1972/.
24. R.Levitin, V.Nitts, S.Niziol, R.Ozerov. *Solid St.Comm.*, 7, 1665 (1969).

Рукопись поступила в издательский отдел
23 мая 1974 года.